" Electros data Discharge

Elehbrosdadische Enfladung, 3. B.

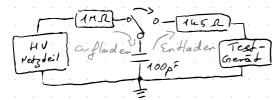
am Türgriff nach einer Aufladung
Teppich durch einen Teppich

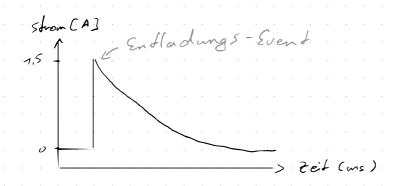
Solche Entladungen hønnen elebbronische Baudeile Jerstren. ESD. Echutz Maßnahmen sollen dies Jerhindern:

- Device-Level ESD: Eine Entladung drifft ein elehtronisches Bandeil
- System-Level ESP: Sine Endladung diffé eine pladue mid mehreren Boundeilen.

Human body Model:

Ein Test, der die Endladung durch Berührung von einem Menschen simmliert.



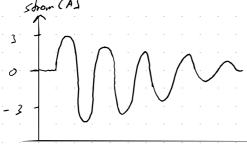


Bei dem Text wird die Spannung erhöht und die EnHadung so lange wiederhold bis das Geräd haputt geht.

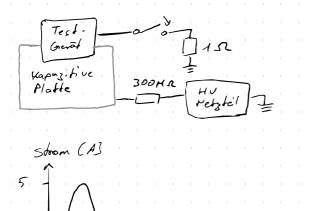
#### Machine Model:

Simulation einer Endladung durch 3.B. einer Pich and Place Maschine

> Zeit (ms)



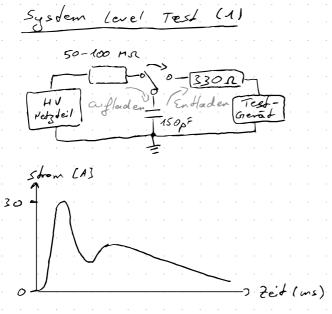
### Charged - Perice Model



Tesden der Enfladung eines Bauteils

Diese Tests finden alle nur auf Device-Level stadt, für System-Level sind andere Tests Vorgesehen

> Zeid [ms]



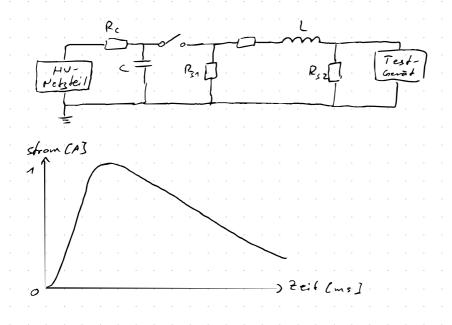
IEC 61000-4-2 Tesa +84v

Hier befinded sich das Bandel nicht mehr in einer hontrollierden Ungebung (Produktions-Bereich).

Die Spannungen sind daher höher als bei

den Device - Level Tests.

System-Level Test (2)



IEC 61000-4-5 Tesd

Dieser Test ist einem Blitzeinschlag sehr

āhnlich

### Was passierd menn eine Entladung einbritt?

1 Gar nichts, das Gerat funktioniert danach immer noch

Viele Hersdeller produzieren ihre Boundeile bis zu einem gewissen Grad ESD geschützt. Duber halten diese Schwächeren untladungen durchaus stand.

- E Soft Failure

  Bantale gehen nicht hapatt aber das
  System muss evtt. nan gestamtet werden.
- Bandeile gehen hapudt und nüssen gedanscht werden

### Wie funktioniert ESD-Schutz?

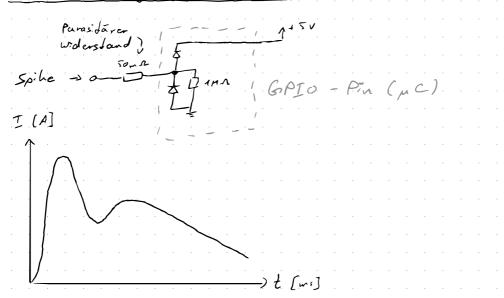
- -> Alle Endladungen verkindern?

  L> Dies ist in der Praxis nicht möglich
- -> Die Effekte von Entladungen reduzieren.
  L> geht, aber nur bis zu einem gewissen Grad

BSP: Die Pins eines Microcondrollers haben indern
eine ESD Prodection für ± 10 v Spihes (Device-Level).

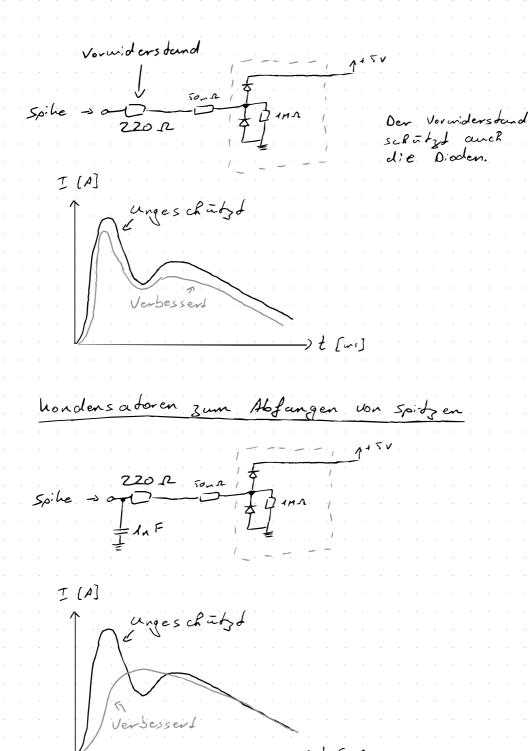
Dementsprechend muss der Sysdem-level
ESD Schutz nur höhere Spannungen abfangen.

### Simulation: Ungeschütztes Bandeil



#### Vorwiders dand

En vorwiderstand verringent den Strom dem das betroffene Banteil stand halten muss. Außerdem sendt er die Resonanzfrequenz des RC-Gliedes.



ESD-Events sind sehr hurg Daher hönnen hondensadoren die hurgen spidzen abfangen.

Sie sind wie Tiefpass-Filder im Einsadz.

Bei hochfrequenden Signalen hönnen hondensadoren aber nicht eingesedzt werden Wenn der hondensadoren wenn der hondensador nicht durch einen Widerstand gedämpft wird, hann er durch Schwingungen das Rausschen verschlechdern.

En größerer hondensador glädded die Peaks Starker

#### TVS Dioden

TVS Dioden verhalden sich ahnlich wie Z-Dioden mit einer schnelleren Reabdons - Zeit und einer höheren Belast barbeit durch Schöme.

Preverse Working Haximum Voldage (VRWM):

Die Maximale Spannung in Sperrvichtung bei

vormaler Benudzung Bsp.: 3,3V Microcontroller,

lier muss die VRWM größer als 3,3V sein.

- Breakdown Voltage (VBR): Spanning, ab der die Diode leidend wird Dioden werden nicht sofort leidend wenn diese Spanning erreicht wird sondern werden in einem Bereich um diese Spanning leidfahiger.

  BSp.: VRWM = 3, 3V, ein passender werden ware UBR = 4.5 V. Ab 4,5 V fangt die Diode an, ein wenig leidfahig zu werden.
- → Clamping Voltage (VCLAMP): Ab dieser

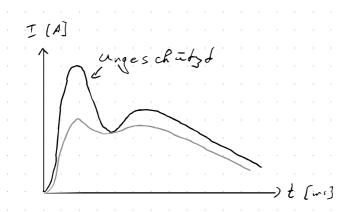
  Spennung had die Diode ihren niedrigsder

  Widerstand erreicht. Ab hier verhält sich die

  Diode wie eine 2 Diode mid einem

  Spennungsabfall von VCLAMP.
- → Dynamic Resisdance (RDYN): Widersdand in leit fähigen Zusdand.

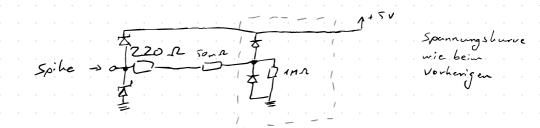
Spile => and I formal Tris Diode



- -> Unipolare Tus Dioden: schützen vor positiven Spikes (2-Diode in Sperrrichdung) und vor regadiven Spikes (Diode in Durchlass richtung)
- -> Bipolare TVS Dioden: Werden bei positiven und regadiren Signalen benötigt.
- -7 Die Vopazidad der Diode beeinflussed das Signal.

Der Shom durch die TVS Diode ist niedriger als der Strom der einen hondensator (Tiefpass) auflädt.

# Qual Schollby Dioden

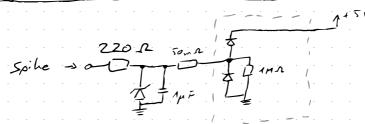


Schoddby Dioden leiden vor den normalen Dioden weil die Forward Voltage niedrig er ist.

Ein Widersdand in Reihe zu der Diode verhindert, dass hohe Ströme die Diode baputt machen.

Die Verwendung dieses Ansadzes hangd von der Impedanz der Spannungsquellen ab Da GNO eine niednige Impedanz hat werden geme TVS Dioden Verwended.

### High-Speed Interface hombination



TUS Dioden mit höheren Stor-hapazitäden sind bessere Tiefpassfilter > Das höchsdmögliche Verwenden ahne das Signal zu Stor

Fast interface: Höherer Vorwidersdand Slow interface Höherer Londensador

### Layond Tipps

- -> TVS Diode so nah wie möglich am Eingang platzieren
- -> Miedrige Eingangs-impedanz niedrig halten (diche braces)
- -> Ungeschützte und geschüdzte Eingange nicht mischen. (cross-dalh/sparhs)
- -> größere Ground-Plane ist immer besser.

## Soft- Failure Vorbengung

-> Watchdag - Timer

-> Checksummen in hommunihadions - Schniddsdellen / CRC

-> Bit - flip Detection im RAM